



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 534 068 A2**

12

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 92111046.6

51 Int. Cl.<sup>5</sup>: H02M 7/5387

22 Anmeldetag: 30.06.92

Ein Antrag gemäss Regel 88 EPÜ auf Berichtigung der Beschreibung liegt vor. Über diesen Antrag wird im Laufe des Verfahrens vor der Prüfungsabteilung eine Entscheidung getroffen werden (Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-V, 2.2).

30 Priorität: 31.07.91 DE 9109503 U

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung: 31.03.93 Patentblatt 93/13

64 Benannte Vertragsstaaten:  
AT CH DE ES FR GB IT LI NL SE

71 Anmelder: MAGTRON MAGNETO  
ELEKTRONISCHE GERÄTE GmbH  
Güterstrasse 21  
W-7583 Ottersweier(DE)

72 Erfinder: Mark, Günter  
Gutenbergstrasse 5b  
W-7583 Ottersweier(DE)

74 Vertreter: Zipse & Habersack  
Lessingstrasse 12  
W-7570 Baden-Baden (DE)

54 Schaltungsanordnung für ein Stromversorgungsgerät für Geräte und Anlagen der Plasma- und Oberflächentechnik.

57 Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung für ein Stromversorgungsgerät für Geräte und Anlagen der Plasma- und Oberflächentechnik. Die Schaltungsanordnung ist dadurch gekennzeichnet, daß zur bipolaren Stromversorgung die positive und negative Ausgangsklemme eines regelbaren Gleichstromnetztes mit dem Brückeneingang einer MOSFET-Brückenschaltung verbunden ist, deren Brückenausgang mit einer Stromerfassungsschaltung zur Steuerung der MOSFETs und mit den Ausgangsklemmen der Last des Plasmagerätes verbunden ist.

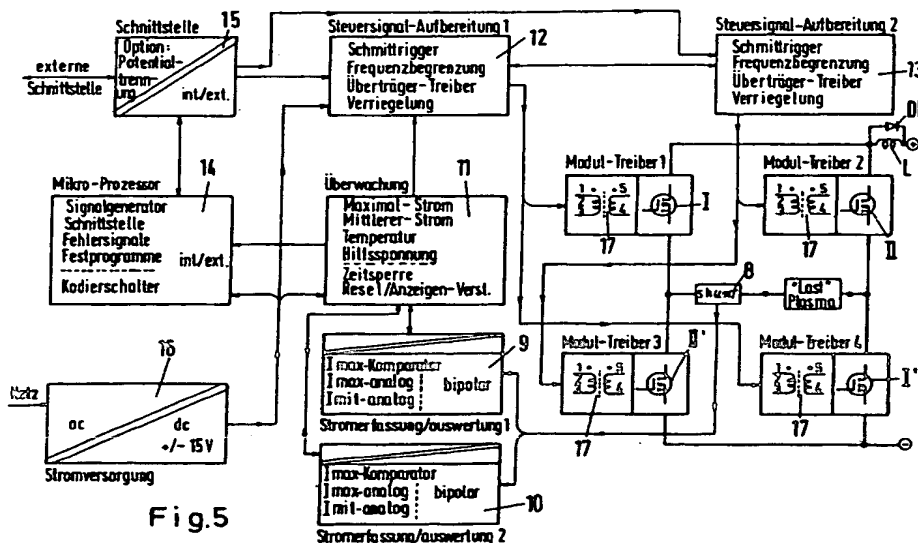


Fig.5

Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung für ein Stromversorgungsgerät für Geräte und Anlagen der Plasma- und Oberflächentechnik.

Bei der Plasmatechnik können auf dem Wege elektrischer Gasentladungen in einem Behälter technische Verfahren angewendet werden, die trocken und berührungslos eine Oberfläche verändern, aktivieren oder beschichten können. Die gewünschten Effekte werden dabei auf physikalischem (PVD) oder können beispielsweise auch auf chemischem Wege (Plasma-CVD) ausgelöst werden.

Zum Betrieb der elektrischen Entladung zur Erzeugung des Plasmas sind Hochfrequenzgeneratoren bekanntgeworden, die den Erfordernissen der Plasmaentladung angepaßt sind. Diese durch Hochfrequenz, beispielsweise mit einer Frequenz von 13,65 MHz, erzeugten Plasmen sind bei hochenergetischen Anwendungen sehr teuer, und die Sicherheitsanforderungen für den Menschen sind recht hoch.

Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, eine Schaltungsanordnung für ein Stromversorgungsgerät für Geräte und Anlagen der Plasma- und Oberflächentechnik zu schaffen, die im Hinblick auf die Lösung des oben genannten Problems wesentliche Vorteile aufweist.

Zur Lösung der gestellten Aufgabe wird eine Schaltungsanordnung für ein Stromversorgungsgerät der eingangs genannten Art vorgeschlagen, welche dadurch gekennzeichnet ist, daß zur bipolaren Stromversorgung die positive und negative Ausgangsklemme eines regelbaren Gleichstromnetzteiles mit den Brückeneingang einer MOSFET-Brückenschaltung verbunden ist, deren Brückenausgang mit einer Stromerfassungsschaltung zur Steuerung der MOSFETs und mit den Ausgangsklemmen der Last des Plasmagerätes verbunden ist.

Mit der Schaltungsanordnung gemäß der Erfindung wird der wesentliche Vorteil erreicht, daß die verhältnismäßig teure HF-Stromversorgung von ca. 13,65 MHz durch eine bipolare Pulsstromversorgung von 0 bis 50 KHz ersetzt wird. Der wesentliche Vorteil des Einsatzes einer bipolaren Pulsstromversorgung liegt vor allem in der besseren Steuerung des Elektronen- und Ionenflusses bei plasmatechnischen Anwendungen. Hierbei kann auf einfache Art und Weise ein steuerbares elektrisches Wechselfeld erzeugt werden.

Gemäß einer besonderen Ausbildung besteht die Schaltungsanordnung nach Anspruch 2 der Erfindung darin, daß mindestens vier MOSFETs mit Modul-Treibern in einer Brückenschaltung zusammengeschaltet sind, deren Eingang mit der positiven und negativen Ausgangsklemme des regelbaren Gleichstromnetzteiles verbunden ist, wobei der Ausgang der Brückenschaltung mit einem Shunt verbunden ist, an dessen Abgriff vorzugsweise zwei Stromerfassungs- und -auswerteeinheiten geschaltet sind, die im wesentlichen einen bipolaren I<sub>max</sub>-Komparator aufweisen, wobei die Stromerfassungs- und -auswerteeinheiten eine Überwachungseinheit für den maximalen und den mittleren Strom, die Temperatur, eine Hilfsspannung, eine Zeitsperre, ein Reset und einen Anzeigeverstärker enthält, wobei die Überwachungseinheit mit einer Mikroprozessoreinheit verbunden ist, die über eine Schnittstelle mit je einer Steuersignalaufbereitung, bestehend aus Schmitttrigger, Frequenzbegrenzung, Übertragertreiber und Verriegelung, mit den Modultreibern des MOSFETs verbunden ist und der Ausgang der Brückenschaltung ferner mit der Last des Plasmagerätes verbunden ist.

Anhand der Zeichnungen soll am Beispiel bevorzugter Ausführungsformen die Schaltungsanordnung gemäß der Erfindung näher erläutert werden.

In den Zeichnungen zeigt

Fig. 1 ein Prinzipblockschaltbild der Schaltungsanordnung zur bipolaren Pulsstromversorgung.

Fig. 2 zeigt das Prinzip der Brückenkonfiguration der MOSFETs.

Fig. 3 zeigt ein Impulsdiagramm der bipolaren Pulsstromversorgung.

Fig. 4 zeigt eine Brückenkonfiguration gemäß Fig. 2 mit anderer Aktivität der Zweige.

Fig. 5 zeigt ein vollständiges Blockschaltbild der Schaltungsanordnung gemäß der Erfindung.

Fig. 6 zeigt ein Blockschaltbild eines Zweiges mit mehreren MOSFETs.

Fig. 7 zeigt ein geändertes Blockschaltbild der Schaltungsanordnung zur bipolaren Pulsstromversorgung.

Fig. 8 zeigt eine Prinzipdarstellung der Schaltungsanordnung gemäß der Erfindung mit einem Prozeßrechner, einer Regeleinrichtung durch mathematische Operationen und einem Vakuumsystem.

Wie sich aus Fig. 1 ergibt, besteht die Schaltungsanordnung für das Gerät zur bipolaren Stromversorgung gemäß der Erfindung aus einem Gleichstromnetzteil 1, dessen positiver Ausgang 2 und dessen negativer Ausgang 3 mit dem Brückeneingang einer MOSFET-Brückenkonfiguration 4 inklusive Steuerelektronik geschaltet ist. Die Ausgänge 5, 5' der Brückenkonfiguration sind mit der Plasmakammer verbunden.

Wie sich aus den Figuren 2 und 4 ergibt, besteht die Brückenschaltung aus je zwei in Brücke geschalteten MOSFETs I, I' und II, II'. An den Brückeneingang sind die beiden Klemmen 2, 3 des Netzteiles 1 geschaltet, so daß die regel- und einstellbare Spannung U<sub>e</sub> der Brücke zugeführt wird. Der Brückenaus-

gang der MOSFET-Brückenschaltung ist mit einem Stromerfassungsbauteil 6 verbunden und führt zu einer Ausgangsklemme 5. Der andere Brückenausgang ist mit dem anderen Ausgang 5' verbunden. Durch entsprechende Ansteuerung der Steuerelektroden der MOSFETs I, I', II, II' kann eine beliebige bipolare Pulsspannung an den Ausgängen 5, 5' erzeugt werden. Im Wechsel wird hierbei die Brückenkonfiguration diagonal geschaltet, so daß die Polarität an den Ausgangsklemmen 5, 5' wechselt. Ist, wie in Fig. 2 dargestellt, der Diagonalzweig I, I' aktiv, ist der Diagonalzweig II, II' inaktiv. Zum Umschalten von einem Diagonalzweig auf den jeweils anderen wird eine Ruhezeit von mindestens 5  $\mu$ s benötigt. Der Stromverlauf ist in Fig. 2 gestrichelt dargestellt. In Fig. 4 ist der Diagonalzweig II, II' aktiv, so daß ein umgekehrter Stromverlauf erfolgt, der ebenfalls gestrichelt dargestellt ist. Die Induktivität L (Figuren 2, 4, 5) schützt den jeweils aktiven MOSFET-Zweig vor einem zu hohen Stromanstieg (DL arbeitet als Freilaufdiode). Das Pulsmuster  $U_a(t)$  mit der kleinsten Periodenzeit ist in Fig. 3 dargestellt. Die Zeiten t1 bis t4 sind frei einstellbar. Desweiteren kann wahlweise nur mit der oberen, positiven Spannungszeitfläche oder mit der unteren, negativen Spannungszeitfläche gearbeitet werden., wobei jeweils dann nur ein Diagonalzweig I, I' oder II, II' aktiv ist.

Die Ausgangsimpulse sind bis zu Spannungslagen von 2500 V und einer Pulsleistung von 10 KW möglich, Spannungslagen bis 1200 V dagegen bis zu einer Pulsleistung von 150 KW. Die obere Grenzfrequenz beträgt 50 KHz.

Bei Normalbetrieb, Spannungsüberschlägen (arcs) oder Kurzschlüssen innerhalb des Plasmas erfaßt der Stromerfassungsbaustein 6 den aktuellen Strom, und es begrenzt die Induktivität L den Stromanstieg (endliches  $\frac{di}{dt}$  zum Schutz der MOSFETs). Der Stromerfassungsbaustein 6 schaltet bei Überstrom den jeweils aktiven Zweig ab. Der Betrieb wird nach Abklingen des Kurzschlußstroms erst wieder fortgesetzt, wenn er den Wert 0 A nahezu erreicht hat.

In Fig. 5 ist ein komplettes Blockschaltbild der Schaltungsanordnung dargestellt. Die MOSFETs I, I' und II, II' sind in einer Brücke geschaltet, und der Stromerfassungsbaustein besteht aus einem Shunt 8, dessen Abgriff mit zwei Stromerfassungs- und -auswertebausteinen 9, 10 verbunden ist, die bipolar einen I<sub>max</sub>-Komparator und eine I<sub>max</sub>-Analog- und I<sub>mit</sub>-Analog-Auswertung umfassen. Die Ausgänge dieser Bausteine sind mit einem Überwachungsbaustein 11 verbunden, der zum Überwachen des Maximalstroms, des mittleren Stroms, der Temperatur und einer Hilfsspannung dient und mit einer Zeitsperre, einem Reset und einem Anzeigeverstärker versehen ist. Der Überwachungsbaustein 11 ist mit einem ersten Steuersignalaufbereitungsbaustein 12 und einem zweiten Steuersignalaufbereitungsbaustein 13 verbunden, wobei über einen Mikroprozessor 14 und eine Schnittstelle 15 die Steuersignalaufbereitungsbausteine 12, 13 gesteuert werden. Diese enthalten einen Schmittigger, eine Frequenzbegrenzung, einen Übertragertreiber und eine Verriegelung. Die Stromversorgung für die gesamte Elektronik ist durch das Bauteil 16 dargestellt.

Die Steuersignale werden von den Bauteilen 12, 13 über besondere Modultreiber 17 den einzelnen MOSFETs I, I' und II, II' zugeführt. Entsprechend dem Programm des Mikroprozessors wird dann die gewünschte bipolare Pulsstromerzeugung durchgeführt.

In Fig. 6 ist ein Teil der gleichen Schaltungsanordnung wie in Fig. 5 dargestellt, wobei jedoch in der Brücke bis zu n MOSFETs mit einer entsprechenden Anzahl von Treibern 17 enthalten sein können. Die Reihenschaltung wird verwendet, um Spannungen bis 2500 V zu realisieren.

Die bipolare Pulsstromversorgung mit einem Gerät mit einer Schaltungsanordnung gemäß der Erfindung weist mehrere Vorteile auf. Die durch Hochfrequenz erzeugten Plasmen sind lokal mit einer Abstrahlungscharakteristik gebunden. Bipolare Pulsplasmen können ein vollständiges Raum-Plasma innerhalb einer Kammer bilden (Potential zwischen Gehäuse und Substrat) und somit Materialien auch bei beliebiger Geometrie vollständig umschließen. Ferner können bipolare Pulsplasmen hochenergetisch bis derzeit 150 KW Pulsleistung aufgebaut und somit auch bei großtechnischen Anlagen industriell eingesetzt werden.

Desweiteren bieten Plasmen, die mit Gleichspannung oder unipolaren Pulsen erzeugt werden, nicht die Möglichkeiten, wie eine bipolare Pulsquelle (z. B. die Beschichtung von Halbleitern und Nichtleitern).

HF-Plasmen bei 13,65 MHz und deren Erzeugung sind bei hochenergetischen Anlagen sehr teuer, wobei die Sicherheitsanforderungen für den Menschen sehr hoch sind. Bei den bipolaren Pulsquellen wird im KHz-Bereich von 0 bis 50 KHz gearbeitet, so daß der Sicherheitsaspekt und die Anlagekosten wesentlich niedriger sind.

Die Schaltungsanordnung gemäß Fig. 7 zeigt eine weitere Variante der Schaltungsanordnung gemäß Fig. 5. Hierbei können als elektronische Leistungsschalter I, I', II, II' in der Brücke alle verfügbaren elektronischen Bauelemente eingesetzt werden, d. h. MOSFETs, bipolare Transistoren, IGBTs (isolated gate bipolar transistor) usw., was auch für die Schaltungsanordnung gemäß Fig. 5 gilt. Zur Realisierung steiler Impulsflanken ist ein kapazitiver Energiespeicher ES der gleichgerichteten Spannung UE nachgeschaltet, der zur Impulsverbesserung beiträgt.

Die Stromanstiegsgeschwindigkeit wird nicht mehr durch die Induktivität L (wie in Fig. 5) im Ausgangskreis begrenzt, sondern im jeweiligen Leistungszweig befindet sich je eine aus einer Induktivität bestehende Stromanstiegsgrenzung SB, die aus einer Induktivität besteht, und Freilaufzweigen FZ, die jeweils durch eine Diode repräsentiert werden. Die Stromerfassung erfolgt durch Stromsensoren SS in den jeweiligen Zweigen und ist separat in ihren Ansprechschwellwerten unabhängig voneinander einstellbar. Es sind zwei besondere Steuerkreise ST1, ST2 vorgesehen, die die Stromerfassung 8 aufnehmen und von einer Mikroprozessorsteuerung 18 und einer analogen OP-Verstärkeranordnung 19 betätigt werden, wodurch die Leistungstreiberansteuerung 20 für die elektronischen Leistungsschalter I, I', II, II' gesteuert werden. Die Mikroprozessorsteuerung 18 und die analoge OP-Verstärkeranordnung 19 sind über eine Schnittstelle mit einem Prozeßrechner 21 verbunden.

Mit der variierten Schaltungsanordnung ist eine Steuerung und Regelung der Plasmaintensität in Abhängigkeit der eingebrachten Leistung, des Ortes und der Zeit einer bipolaren Pulsstromversorgung möglich.

Bedingt durch die freie Einstellbarkeit und Wahlmöglichkeit für die bipolare Pulseinheit gemäß der Schaltungsanordnung nach der Erfindung in DC +, DC -, unipolar +, unipolar - und bipolar sind Steuer- und Regelfunktionen möglich, die eine Plasmabearbeitung von Materialien, wie Leiter, Halbleiter und Nichtleiter, ermöglichen.

Die Steuerung der Plasmaintensität als Funktion des Ortes XYZ und der Zeit t sowie der eingebrachten Leistung P über das Plasma zwischen den elektrisch leitenden Flächen A, B ist in Fig. 8 dargestellt. Das Substrat kann von den Grenzflächen A oder B gebildet werden. Bei halb- und nichtleitenden Substraten kann es sich außerhalb der Grenzflächen A, B, wie durch SU in Fig. 8 dargestellt, an einem frei wählbaren Ort innerhalb des Plasmasystems befinden. A oder B kann auch die Kammerwand des Vakuumsystems oder Teile davon selbst darstellen, in dem das Vakuum erzeugt wird.

Über den Prozeßrechner 18 werden mit dem Prozeßvektor P (P1 ... Pp) der Regel- und Steuereinheit ST1, ST2 Befehle und Meldungen übermittelt. Der Regelvektor R (R1... Rr) bewirkt mit der bipolaren Pulseinheit als Stellglied die Steuerung und Regelung des Plasmas. Dadurch ist eine schnelle Regelung mit beliebig konfigurierbaren, mathematischen Operationen möglich. Für hochempfindliche, hochgenaue und vor allem zur Instabilität neigende Plasmaprozesse (arcing) kann es notwendig sein, eine schnelle Regelung mit beliebig konfigurierbaren mathematischen Operationen optional zu verwenden, wie in Fig. 8 dargestellt. Als Ist-Werte dienen die elektrischen Größen  $u_a(t) = u_+(t) + u_-(t)$  und  $i_a(t) = i_+(t) + i_-(t)$ ,  $\oplus$  = positiver Puls,  $\ominus$  = negativer Puls.

Aus diesen elektrischen Größen können innerhalb eines Meßzyklus  $\bar{Z}$  ( $\bar{Z}$  kann sich auf beliebig viele Meßperioden erstrecken) über bekannte, analoge Operationsverstärkerschaltungen (Addierer, Subtrahierer, Integrierer, Differenzierer, PI - PID-Regler usw.) 19 folgende Größen ermittelt werden:

1) Spannung

$$U_{\oplus} = \int_{\bar{Z}} U_{\oplus}(t) dt$$

$$U_{\ominus} = \int_{\bar{Z}} U_{\ominus}(t) dt$$

$$\Delta U = U_{\oplus} - U_{\ominus} = \text{const.}$$

$\Delta U$  beliebig einstell-

bar / regelbar zwischen

$U_{\oplus}$  und  $U_{\ominus}$

2) Strom

$$I_{\oplus} = \int_{\bar{Z}} i_{\oplus}(t) dt$$

$$I_{\ominus} = \int_{\bar{Z}} i_{\ominus}(t) dt$$

$$\Delta I = i_{\oplus} - i_{\ominus} = \text{const.}$$

$\Delta I$  beliebig einstell-

bar / regelbar zwischen

$I_{\oplus}$  und  $I_{\ominus}$

3) Leistung

$$P_{\oplus} = \int_{\bar{Z}} U_{\oplus}(t) \cdot i_{\oplus}(t) dt$$

$$P_{\ominus} = \int_{\bar{Z}} U_{\ominus}(t) \cdot i_{\ominus}(t) dt$$

$$\Delta P = P_{\oplus} - P_{\ominus} = \text{const.}$$

$\Delta P$  beliebig einstell-

bar / regelbar zwischen

$P_{\oplus}$  und  $P_{\ominus}$

Die entsprechenden Sollwert-Einstellungen zur Bildung von 1) bis 3) sind vollautomatisch über den Prozeßvektor P oder über eine manuelle Einstellung möglich. Je nach plasmatechnischer Anwendung, wie z. B.

Ätzen (Reinigen),

Härten,  
Beschichten,  
Implantieren,  
Erwärmung (ohne Härtung),  
Sputtern usw.

kann eine Auswahl 1 aus 3 getroffen werden. Diese Art, das Plasma über die elektrischen Größen  $u_a(t)$ ,  $i_a(t)$ ,  $P_a(t)$  direkt zu regeln, ist in dieser Anordnung durch die direkte Beeinflussung der Pulszeitflächen  $\Phi$  und  $\Theta$  im  $\mu s$ - bis  $sec$ -Bereich sehr exakt möglich. Eine z. B. prozeßrechnergesteuerte Plasmaintensitätsfunktion ( $x, y, z, t, u, \Phi, \Theta, i, \Theta, \vartheta, U_{Pot} \dots$ ) kann zur Substratbearbeitung bzw. Behandlung sehr komplexer Prozesse hinzugezogen werden. Eine geeignete Sensorik, z. B. eine Temperaturverteilung ( $\vartheta$ ) oder eine Spannungspotentialverteilung ( $U_{Pot}$ ), kann als überlagerte Regelung mit hinzugezogen werden. Dies ist durch das Bezugszeichen 22 in Fig. 8 angedeutet.

Eine hochleistungsfähige elektrische Pulsmessung  $u_a(t)$ ,  $i_a(t)$ ,  $P_a(t)$  mit entsprechender Regelung kann dazu dienen, Elektronen- und Ionenströme optimal für einen Plasmaprozeß zu regeln. Hohlkathodenefekte können z. B. mit der bipolaren Technik durch die separate Steuerung/Regelung der positiven und negativen Pulsanteile eliminiert werden. Die arc-Empfindlichkeit kann bei schnellen Übergängen von der Glühentladung zur Bogenentladung reduziert bzw. vermieden werden.

Das Gerät gemäß der Erfindung ist für plasmagestützte Verfahren einsetzbar, wie zum Beispiel:

- PVD-Technik (PVD = physical vapor deposition),
- CVD-Technik (CVD = chemical vapor deposition),
- Plasma-CVD,
- Plasmanitrieren,
- Kathodenzerstäubung,
- Oberflächenreinigung (Ätzen mittels Plasma),
- Plasmatechnische Behandlung (Beschichtung, Reinigung),
- Ionenimplantation.

#### Patentansprüche

1. Schaltungsanordnung für ein Stromversorgungsgerät für Geräte und Anlagen der Plasma- und Oberflächentechnik, **dadurch gekennzeichnet**, daß zur bipolaren Stromversorgung die positive und negative Ausgangsklemme eines regelbaren Gleichstromnetztes mit dem Brückeneingang einer MOSFET-Brückenschaltung verbunden ist, deren Brückenausgang mit einer Stromerfassungsschaltung zur Steuerung der MOSFETs und mit den Ausgangsklemmen der Last des Plasmagerätes verbunden ist.
2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß mindestens vier MOSFETs mit Modul-Treibern in einer Brückenschaltung zusammengeschaltet sind, deren Eingang mit der positiven und negativen Ausgangsklemme des regelbaren Gleichstromnetztes verbunden ist, wobei der Ausgang der Brückenschaltung mit einem Shunt verbunden ist, an dessen Abgriff vorzugsweise zwei Stromerfassungs- und -auswerteeinheiten geschaltet sind, die im wesentlichen einen bipolaren I<sub>max</sub>-Komparator aufweisen, wobei die Stromerfassungs- und -auswerteeinheiten eine Überwachungseinheit für den maximalen und den mittleren Strom, die Temperatur, eine Hilfsspannung, eine Zeitsperre, ein Reset und einen Anzeigeverstärker enthält, wobei die Überwachungseinheit mit einer Mikroprozessoreinheit verbunden ist, die über eine Schnittstelle mit je einer Steuersignalaufbereitung, bestehend aus Schmitttrigger, Frequenzbegrenzung, Übertragertreiber und Verriegelung, mit den Modultreibern der MOSFETs verbunden ist und der Ausgang der Brückenschaltung ferner mit der Last des Plasmagerätes verbunden ist.
3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 und 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß eine Stromanstiegsbegrenzung (SB) mit jeweiligem Freilaufzweig (FZ) im Leistungszweig der elektronischen Schalter (I, I', II, II') angeordnet ist, und daß die Stromerfassung durch zwei Stromsensoren (SS) in den jeweiligen Zweigen erfolgt, die separat unabhängig voneinander einstellbar sind, wobei ferner zwei Steuerkreise (ST1, ST2) vorgesehen sind, die die Stromerfassung (8) aufnehmen und von einer Mikroprozessorsteuerung (18) und einer analogen OP-Verstärkeranordnung (19) betätigt werden, wodurch die Leistungstreiberansteuerung (20) für die elektronischen Leistungsschalter (I, I', II, II') gesteuert werden, wobei die Mikroprozessorsteuerung (18) und die analoge OP-Verstärkeranordnung (19) über je eine Schnittstelle mit einem Prozeßrechner (21) verbindbar sind.

4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Leistungsschalter (I, I', II, II') bipolare Transistoren, IGBTs oder andere schnell schaltende elektronische Leistungshalbleiter sind.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig.1

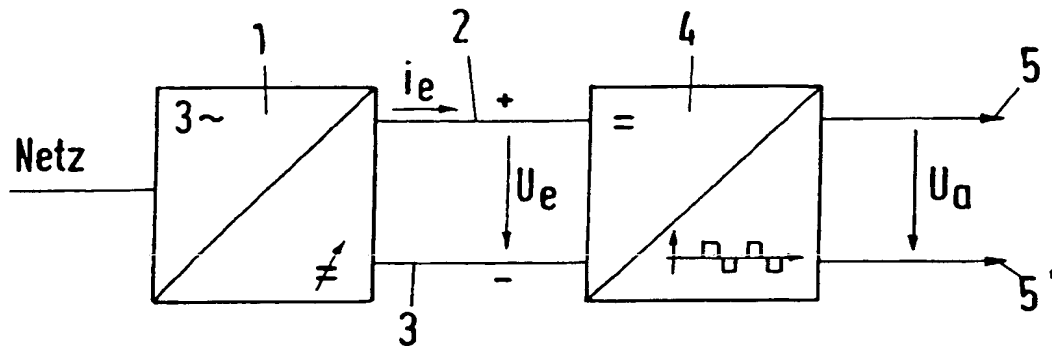
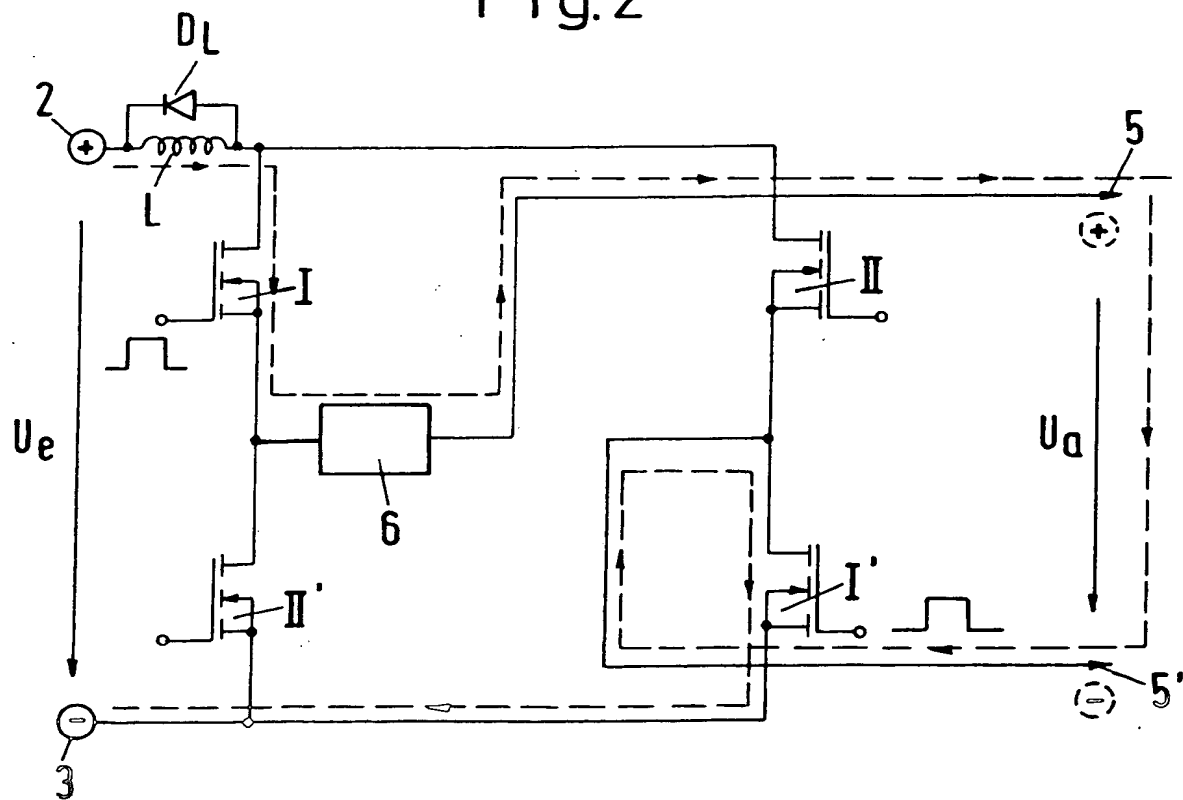


Fig.2



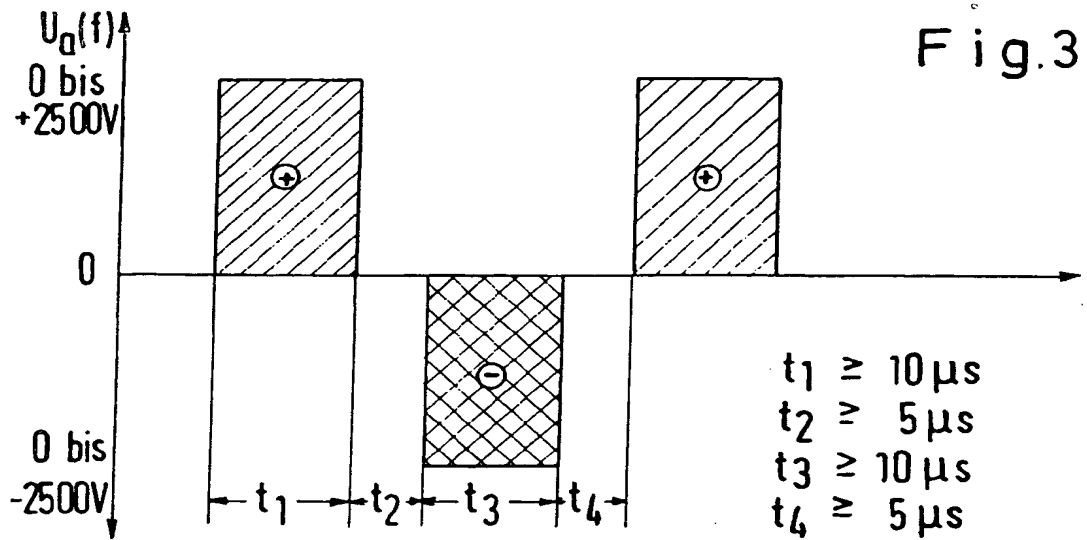
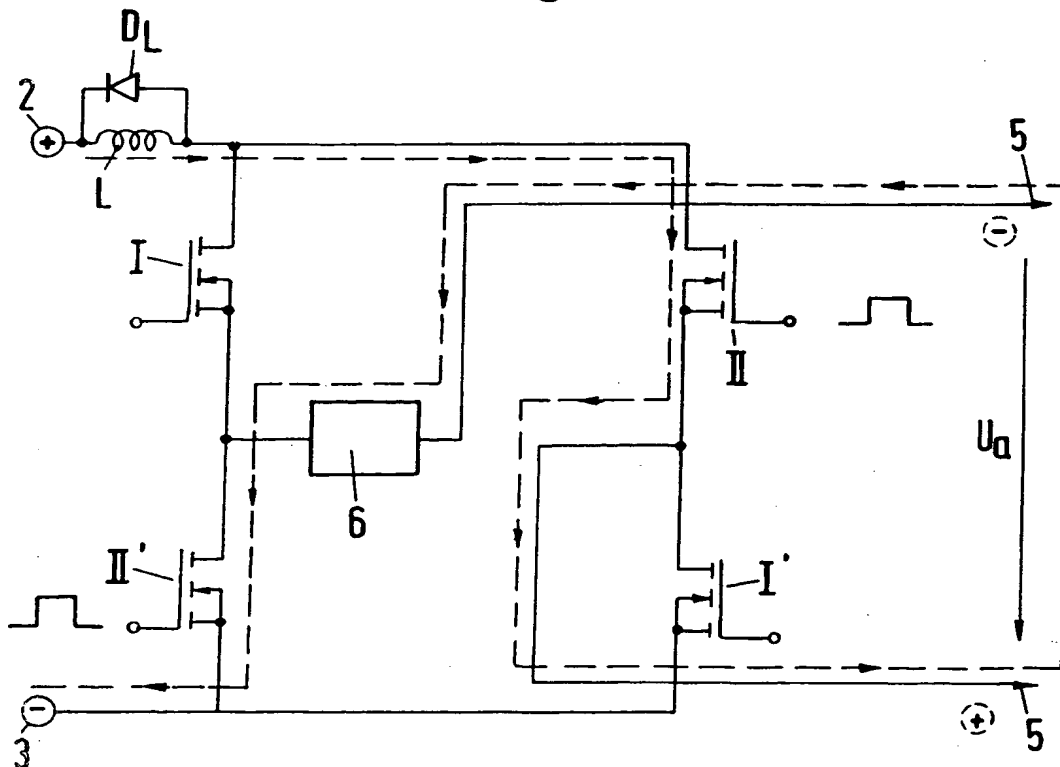


Fig.4





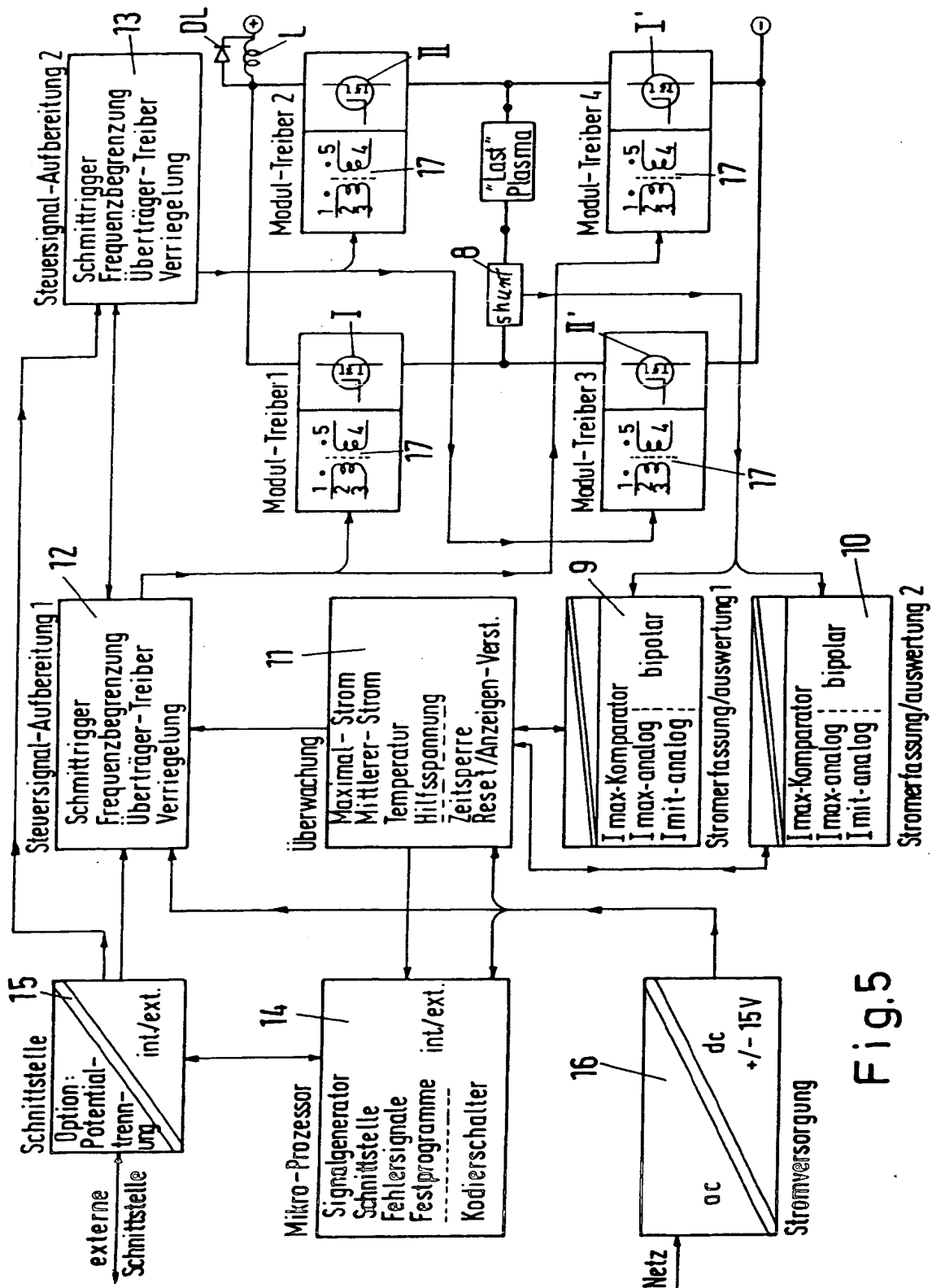
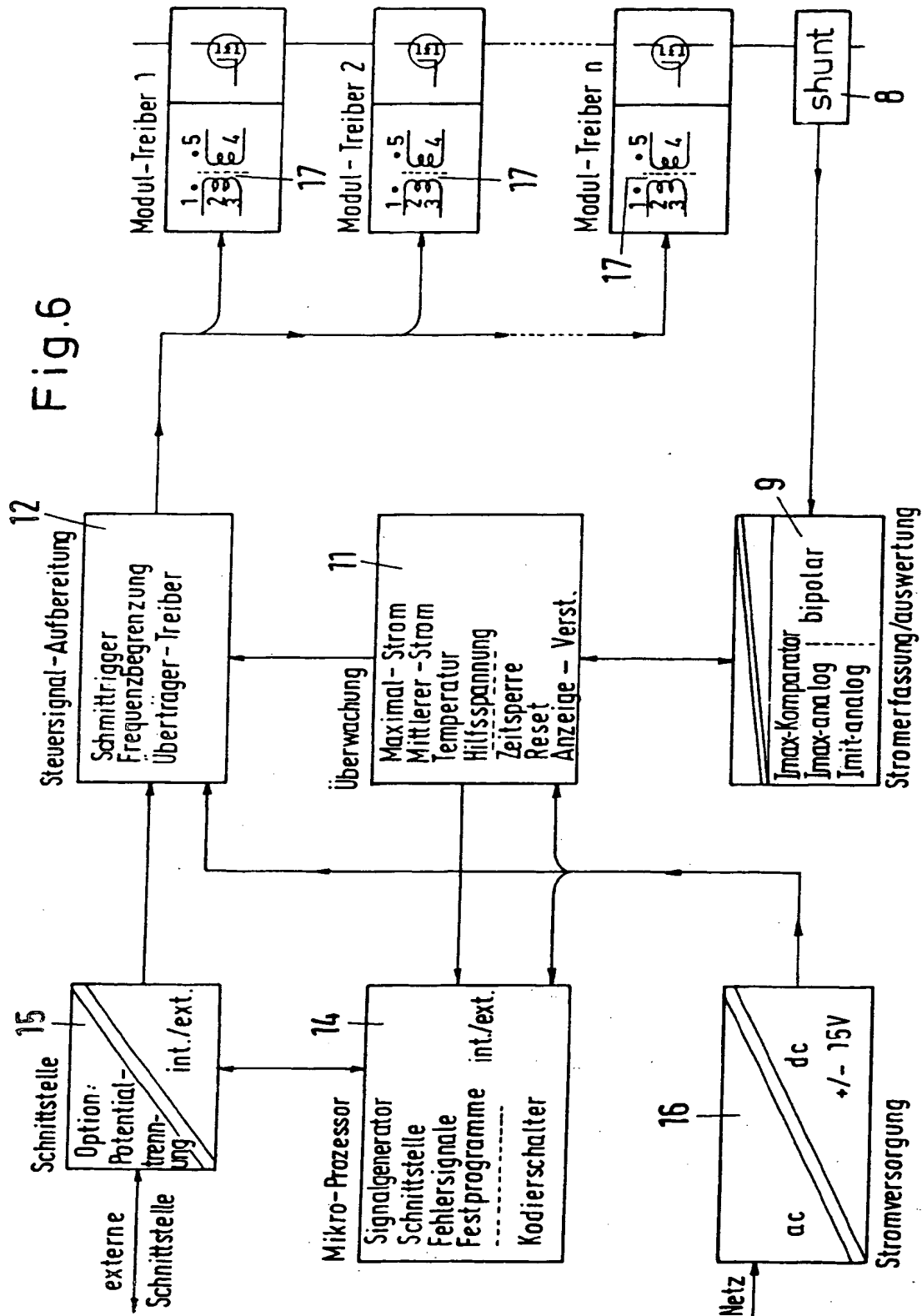


Fig.5



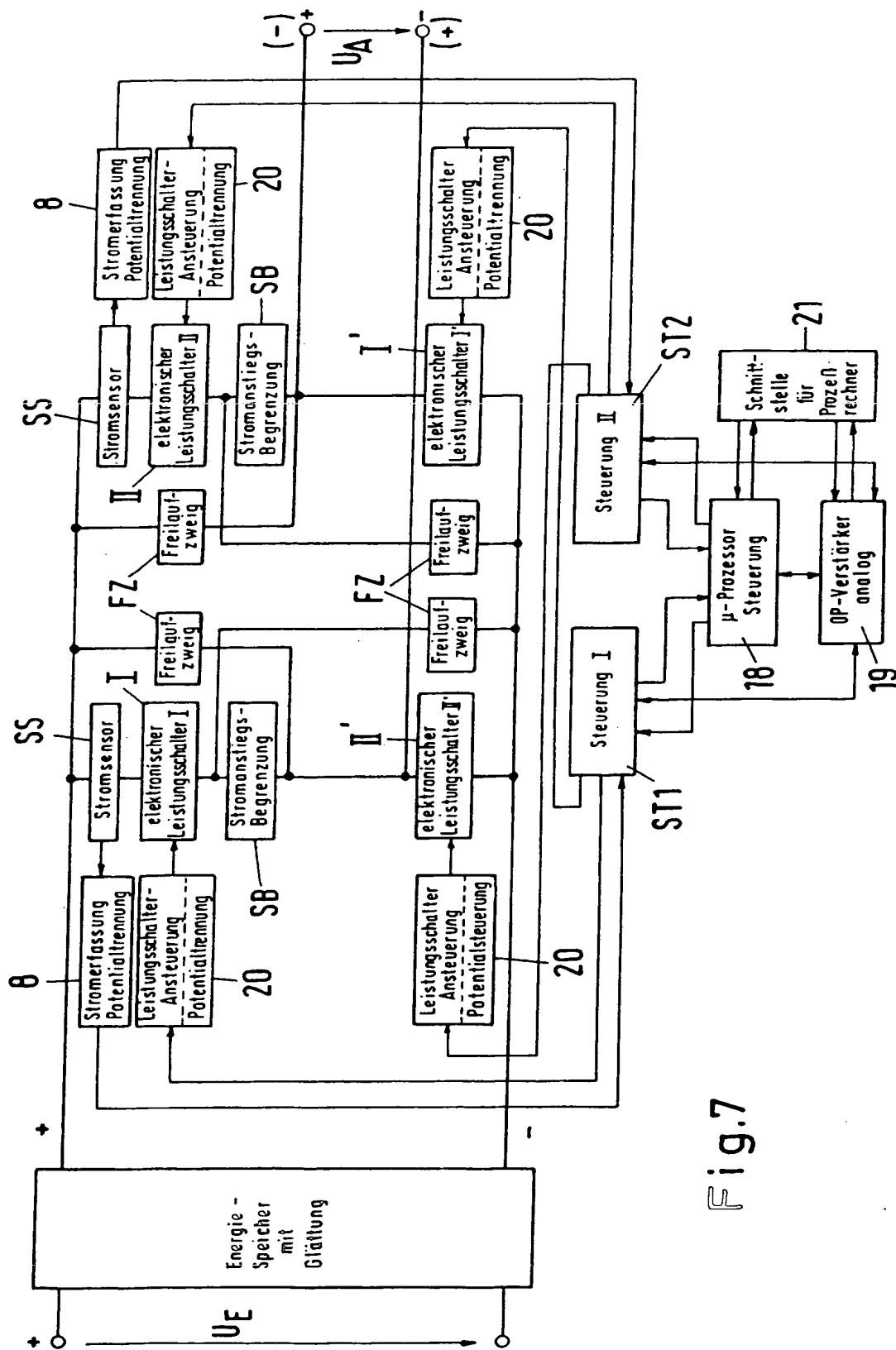
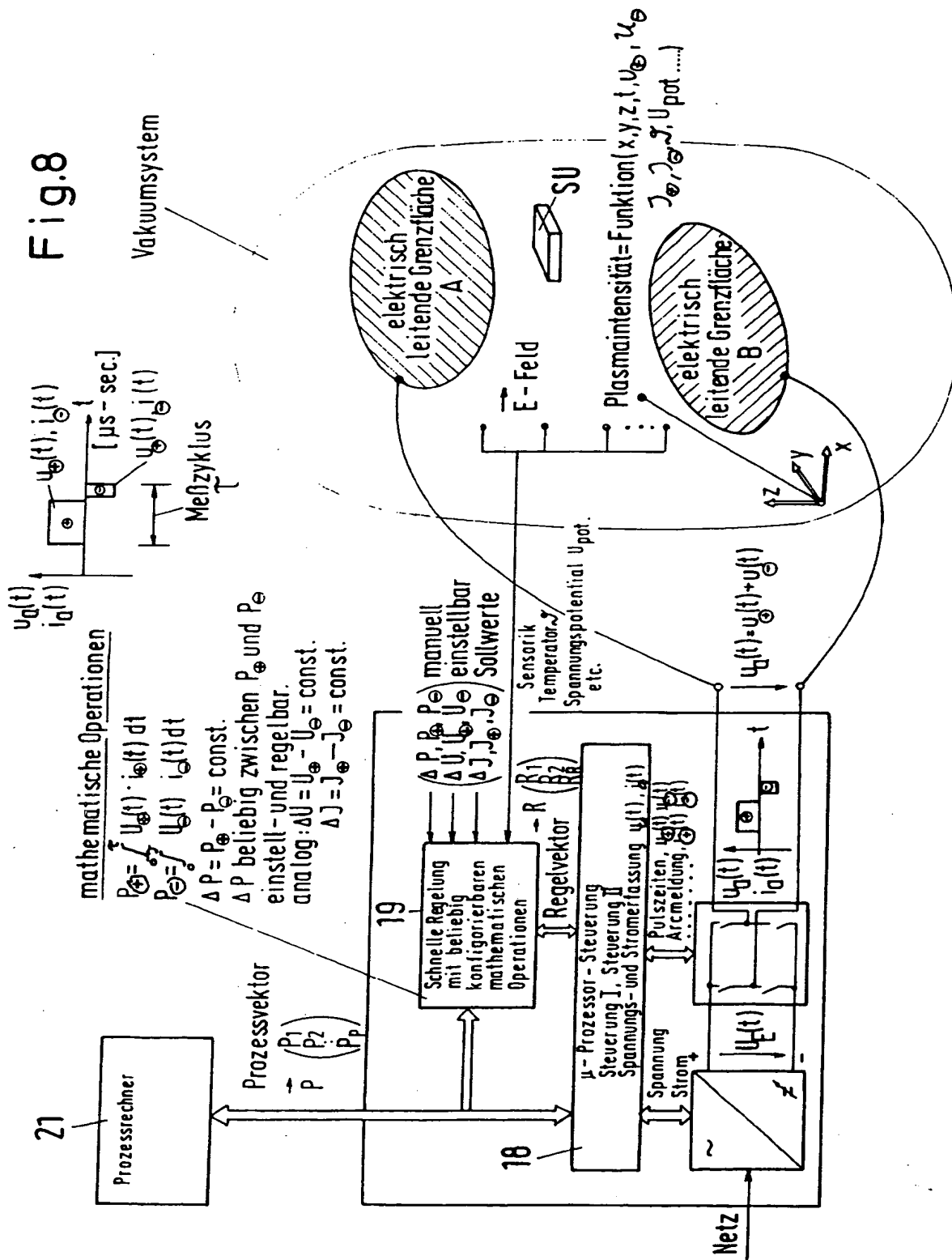


Fig.7





Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 534 068 A3**

12

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: **92111046.6**

51 Int. Cl.<sup>5</sup>: **H02M 7/5387**

22 Anmeldetag: **30.06.92**

30 Priorität: **31.07.91 DE 9109503 U**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**31.03.93 Patentblatt 93/13**

84 Benannte Vertragsstaaten:  
**AT CH DE ES FR GB IT LI NL SE**

88 Veröffentlichungstag des später veröffentlichten  
Recherchenberichts: **30.06.93 Patentblatt 93/26**

71 Anmelder: **MAGTRON MAGNETO**

**ELEKTRONISCHE GERÄTE GmbH**  
**Güterstrasse 21**  
**W-7583 Ottersweier(DE)**

72 Erfinder: **Mark, Günter**  
**Gutenbergstrasse 5b**  
**W-7583 Ottersweier(DE)**

74 Vertreter: **Zipse & Habersack**  
**Lessingstrasse 12**  
**W-7570 Baden-Baden (DE)**

54 **Schaltungsanordnung für ein Stromversorgungsgerät für Geräte und Anlagen der Plasma- und Oberflächentechnik.**

57 Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung für ein Stromversorgungsgerät für Geräte und Anlagen der Plasma- und Oberflächentechnik. Die Schaltungsanordnung ist dadurch gekennzeichnet, daß zur bipolaren Stromversorgung die positive und negative Ausgangsklemme eines regelbaren Gleichstromnetz-

teiles mit dem Brückeneingang einer MOSFET-Brückenschaltung verbunden ist, deren Brückenausgang mit einer Stromerfassungsschaltung zur Steuerung der MOSFETs und mit den Ausgangsklemmen der Last des Plasmagerätes verbunden ist.

EP 0 534 068 A3

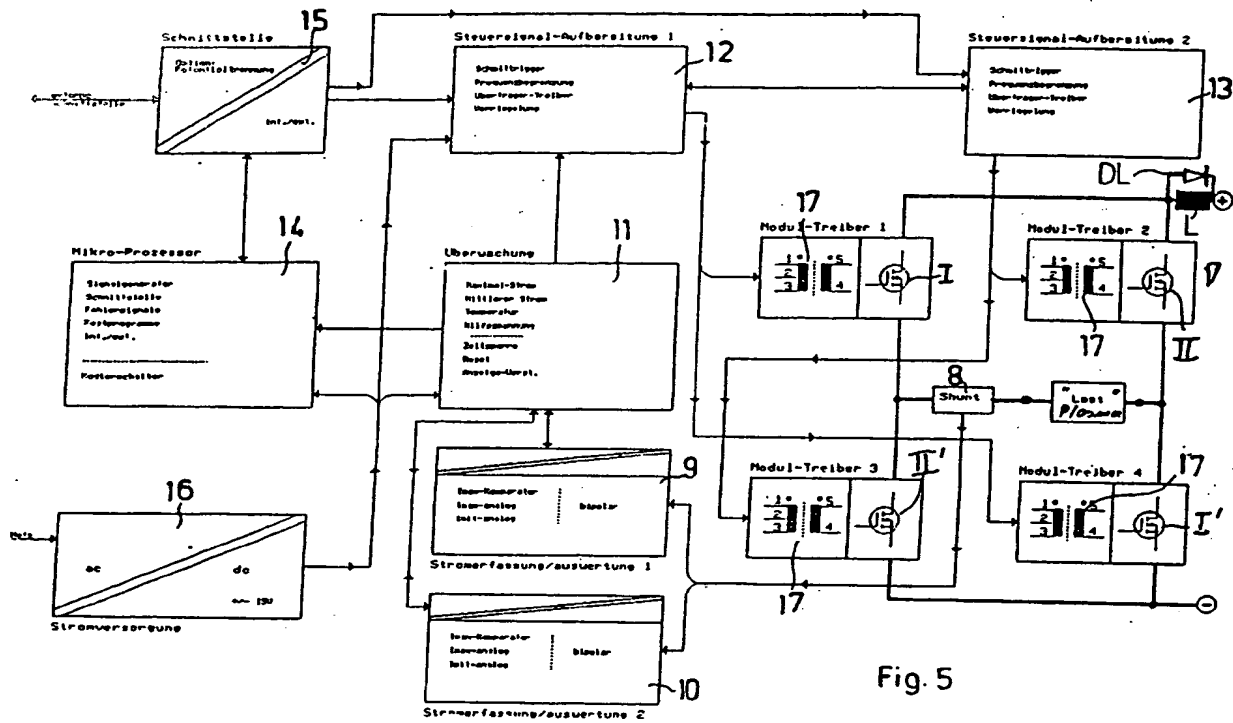


Fig. 5



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 92 11 1046

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. CL.5)
X	DE-A-3 733 263 (G.H. INDUSTRIAL S.A.)	1,4	H02M7/5387
Y	* das ganze Dokument *	2	
Y	---		
Y	US-A-4 520 437 (BOETTCHER) * Spalte 4, Zeile 11 - Zeile 62; Abbildung 4 *	2	
A	---		
A	US-A-4 719 558 (HANADA) * Abbildung 3 *	3	
A	---		
A	DE-A-3 712 185 (HITACHI) * Zusammenfassung; Abbildungen 3,4 *	3	
A	---		
A	GB-A-2 143 998 (FERRANTI) * Zusammenfassung; Abbildung 4 *	3	
	-----		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 29 APRIL 1993	Prüfer GENTILI L.
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b>			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument A : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

